

М2ТКИ-75-12ЧШ

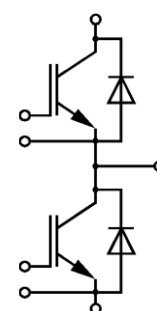
СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

- полумост
- корпус с изолированным основанием
- низкое значение энергий коммутационных потерь при включении E_{on} и выключении E_{off}
- оптимальные частоты коммутации 15-35 кГц



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- преобразователи частоты
- источники бесперебойного питания
- сварочное оборудование
- ПСН подвижного состава железных дорог



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- $V_{CES} = \underline{1200 \text{ В}}$
- $V_{CEsat} = \underline{3.2 \text{ В}}$ (тип.)
- $T_{j \max} = \underline{150 \text{ °C}}$
- $I_C = \underline{75 \text{ А}}$
- $V_F = \underline{1.5 \text{ В}}$ (тип.)
- $V_{isol} = \underline{2500 \text{ В}}$

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CE}	1200	В
Напряжение затвор-эмиттер	V_{GE}	± 20	
Постоянный ток коллектора	I_C	при $T_C = 25 \text{ °C}$	А
		при $T_C = 70 \text{ °C}$	
Импульсный ток коллектора ($t_p = 1 \text{ мс}$, $T_C = 70 \text{ °C}$)	I_{Cpuls}	150	
Постоянный прямой ток, диод обратного тока	I_F	75	
Повторяющийся импульсный прямой ток, диод обратного тока	I_{FRM}	150	
Суммарная мощность рассеивания (на один ключ, $T_C = 25 \text{ °C}$), IGBT	P_{tot}	650	Вт
Максимальная температура перехода	T_j	+ 150	°C
Температура хранения	T_{stg}	- 50...+ 125	
Напряжение изоляции ($t = 1 \text{ мин.}$)	V_{isol}	2500	В (эфф)



М2ТКИ-75-12ЧШ

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT (на один ключ)	R_{thjc}	≤ 0.19	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока (на один ключ)	R_{thjcD}	≤ 0.7	
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1 \text{ Вт/м} \cdot \text{°C}$, на модуль (типичное значение)	R_{thck}	0.03	°C/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °C, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Статические характеристики					
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ($V_{GE} = V_{CE}$, $I_C = 3 \text{ mA}$)	$V_{GE(th)}$	4.5	5.5	6.5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($V_{GE} = 15 \text{ В}$, $I_C = 75 \text{ A}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	V_{CEsat}	- -	3.2 3.85	3.70 -	
Ток утечки коллектор-эмиттер ($V_{CE} = 1200 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$	I_{CES}	-	-	1.5	мА
Ток утечки затвор-эмиттер ($V_{GE} = 20 \text{ В}$, $V_{CE} = 0 \text{ В}$)	I_{GES}	-	-	400	нА
Заряд затвора ($V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$)	Q_G	-	0.8	-	мкКл
Характеристики на переменном токе					
Входная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$)	C_{ies}	-	5.10	-	нФ
Обратная переходная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$)	C_{res}	-	0.32	-	
Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при $T_{vj} = 125 \text{ °C}$)					
Время задержки включения ($V_{CE} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 75 \text{ A}$, $R_G = 7.5 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(on)}$	- -	0.12 0.13	- -	мкс



М2ТКИ-75-12ЧШ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Время нарастания ($V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 75$ А, $R_G = 7.5$ Ом) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	t_r	- -	0.05 0.06	- -	мкс
Время задержки выключения ($V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 75$ А, $R_G = 7.5$ Ом) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	$t_{d(off)}$	- -	0.31 0.36	- -	
Время спада ($V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 75$ А, $R_G = 7.5$ Ом) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	t_f	- -	0.02 0.03	- -	
Энергия потерь при включении ($V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 75$ А, $R_G = 7.5$ Ом, $T_j = 125$ °С, $L_S = 30$ нГн, за один импульс)	E_{on}	-	9.0	-	мДж
Энергия потерь при выключении ($V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 75$ А, $R_G = 7.5$ Ом, $T_j = 125$ °С, $L_S = 30$ нГн, за один импульс)	E_{off}	-	3.8	-	
Ток короткого замыкания ($t_p \leq 10$ мкс, $V_{CC} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma(CE)} \times di/dt$, $T_j = 125$ °С)	I_{SC}	-	450	-	кА
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	19	-	нГн



М2ТКИ-75-12ЧШ

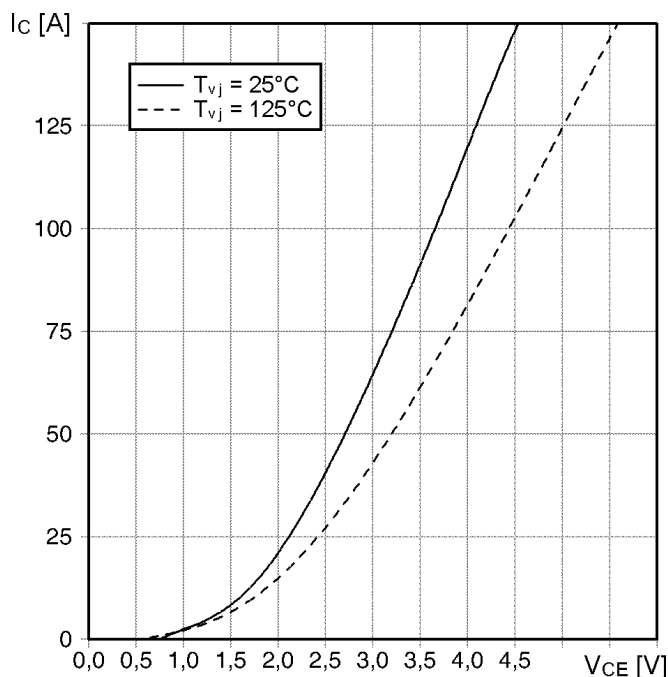
Наименование Параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Характеристики диода обратного тока					
Прямое падение напряжения ($I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ B}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	V_F	- -	1.50 2.10	2.00 -	В
Ток обратного восстановления ($I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ B}$, $V_R = 600 \text{ B}$, $di_F/dt = -2700 \text{ A/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	I_{rr}	- -	30 30	- -	А
Время обратного восстановления ($I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ B}$, $V_R = 600 \text{ B}$, $di_F/dt = -2700 \text{ A/мкс}$, $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$)	t_{rr}	-	25	-	нс
Заряд обратного восстановления ($I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ B}$, $V_R = 600 \text{ B}$, $di_F/dt = -2700 \text{ A/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	Q_{rr}	- -	0.42 0.45	- -	мкКл
Энергия потерь обратного восстановления ($I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ B}$, $V_R = 600 \text{ B}$, $di_F/dt = -2700 \text{ A/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	E_{rec}	- -	0.30 0.45	- -	мДж

М2ТКИ-75-12ЧШ

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

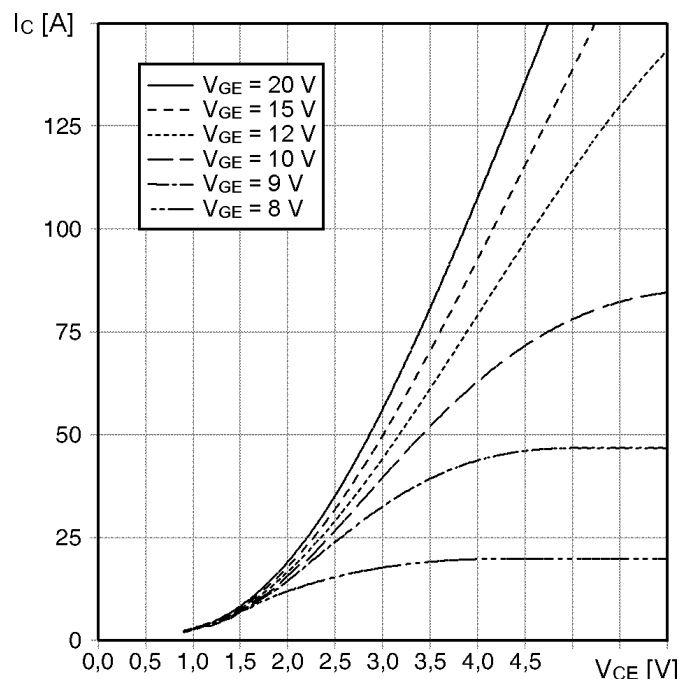
Режим измерения: $V_{GE} = +15 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

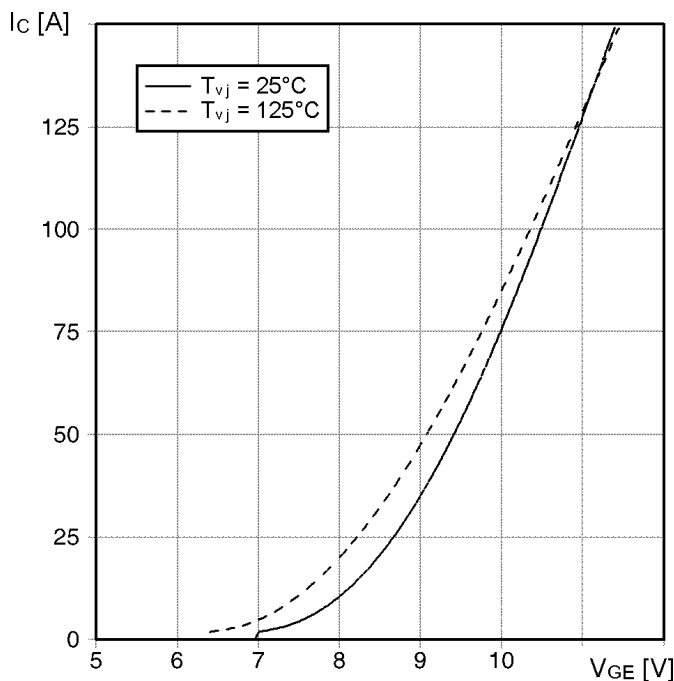
Режим измерения: $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$

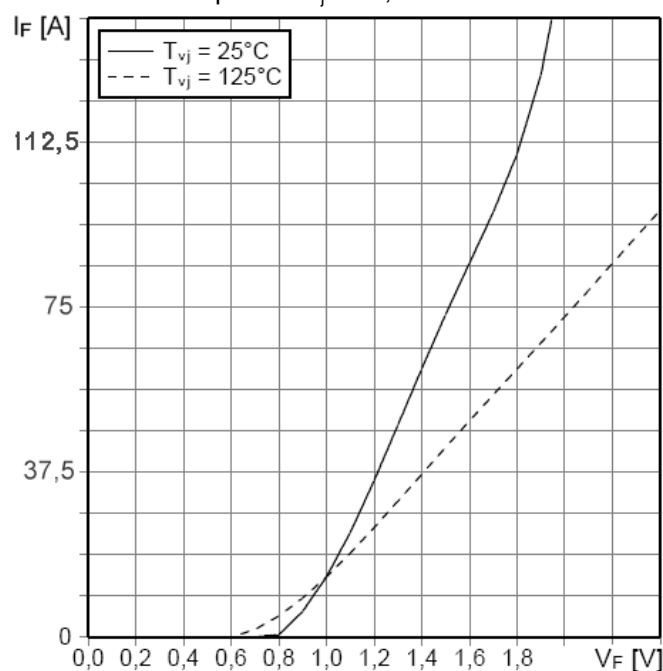
Режим измерения: $V_{CE} = 20 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые прямые характеристики
 диода обратного тока

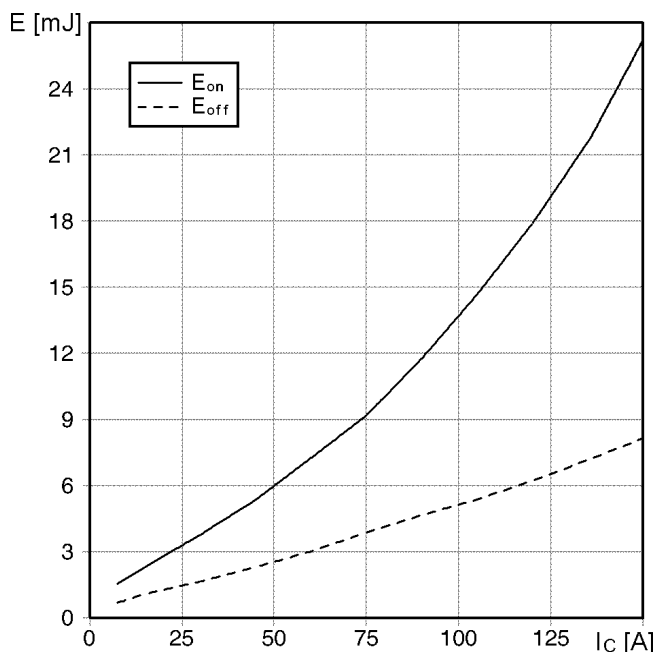
$$I_F = f(V_F)$$

Режим измерения: $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$

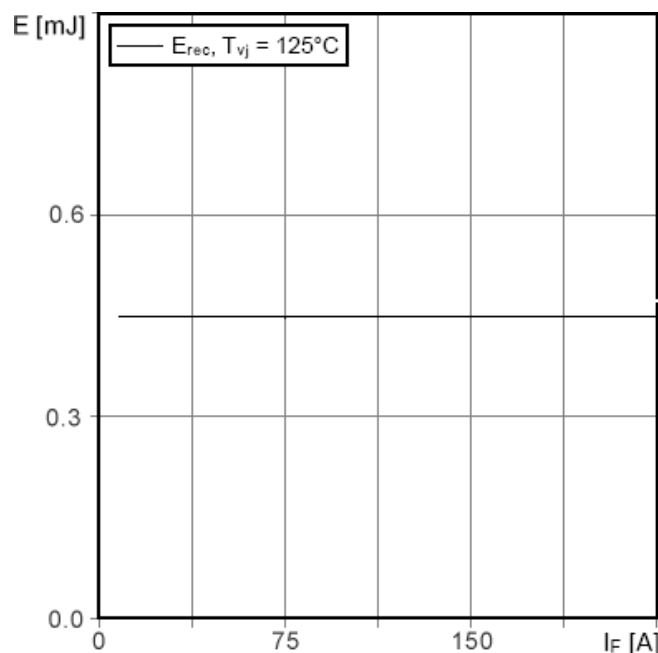


М2ТКИ-75-12ЧШ

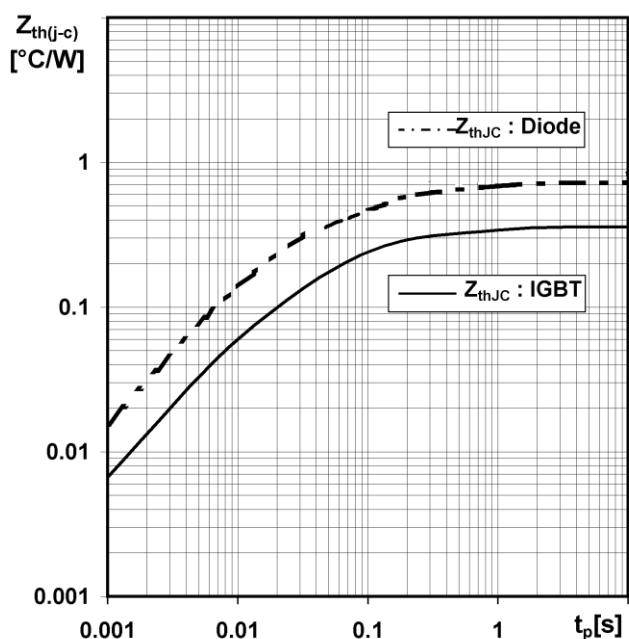
Типовые зависимости коммутационных потерь
 $E_{off} = f(I_C)$, $E_{on} = f(I_C)$, индуктивная нагрузка
 Режим измерения: $V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В,
 $R_{G(on)} = 7.5$ Ом, $R_{G(off)} = 7.5$ Ом, $T_j = 125$ °С



Типовые зависимости коммутационных потерь
 $E_{rec} = f(I_F)$, индуктивная нагрузка
 Режим измерения: $V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В,
 $R_{G(on)} = 7.5$, $R_{G(off)} = 7.5$ Ом, $T_j = 125$ °С

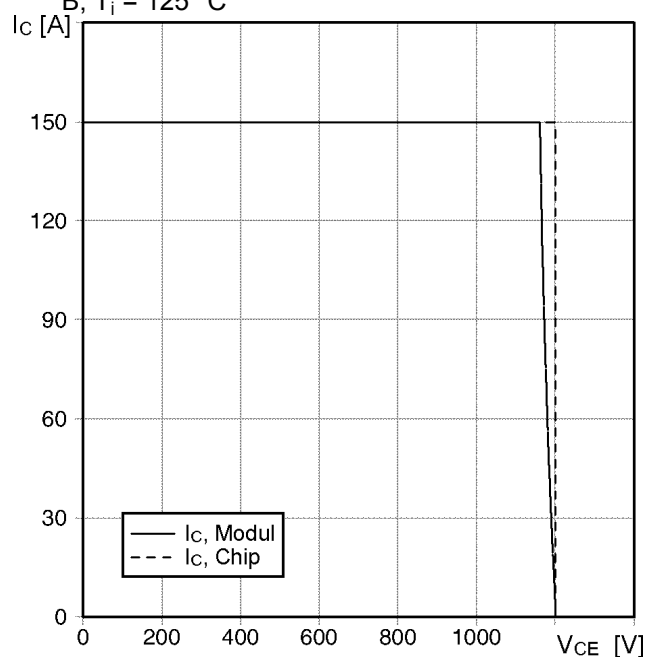


Переходное тепловое сопротивление на IGBT,
 диоде обратного тока
 $Z_{thjc} = f(t_p)$, $Z_{thjc} = f(t_p)$



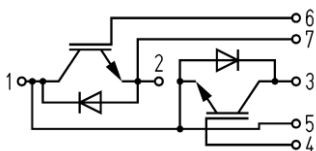
Обратная область безопасной работы

$I_{C\ puls} = f(V_{CE})$
 Режим измерения: $R_{G(off)} = 7.5$ Ом, $V_{LF} = V_{LR} = 15$ В, $T_j = 125$ °С

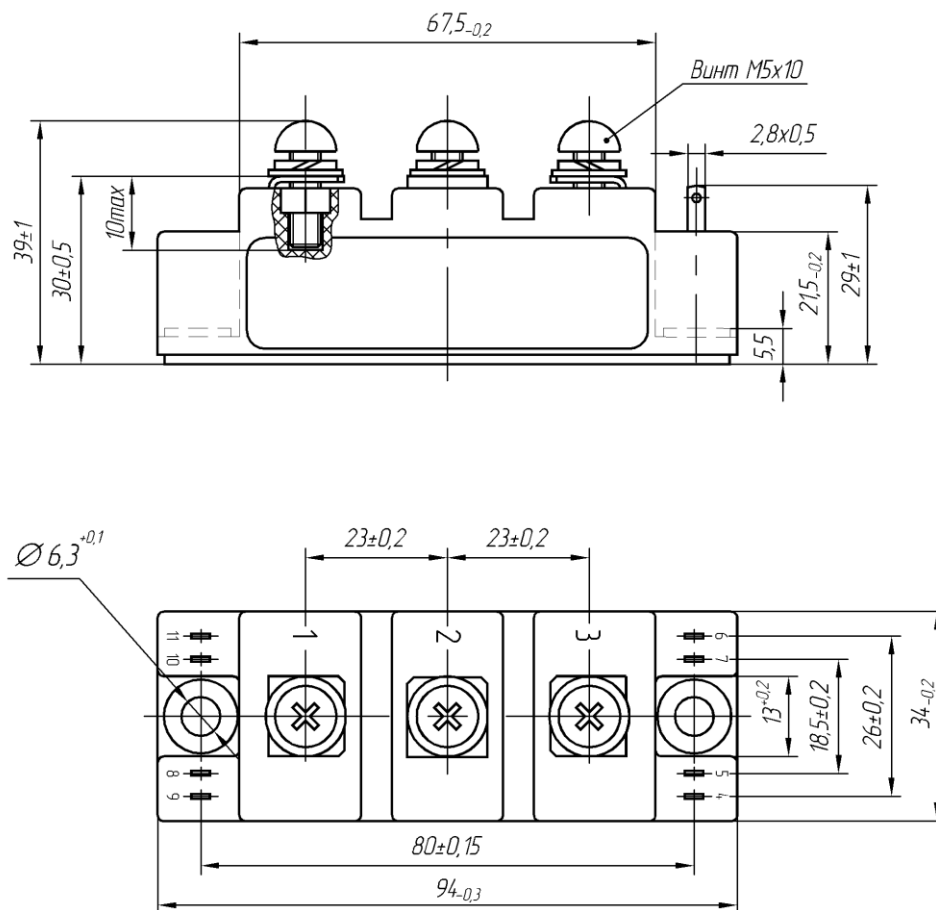


М2ТКИ-75-12ЧШ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Масса 0.165 кг

Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Телефон/Факс: +7 (8342) 48-07-33, 27-02-83 (маркетинг)

29-60-72, 29-68-29 (техническая поддержка)

E-mail: martin@moris.ru, nicpp@saransk-com.ru (техническая поддержка)

Internet: www.elvpr.ru/